High-β 加速管の加速電場安定度に対する要求仕様

KEK 2001.5.21 T. Kato

まとめ

超伝導陽子リニアックの出力エネルギー偏移は、ランダムタンクエラーが+-0.2%, 0.2 度の時に、 +-700 keV 以上となり、デバンチャーの位相が 25 度もずれて、デバンチャーの適切な動作を期待で きない。この観点からの超伝導陽子リニアックに要請される電場安定度は、+-0.1%以下と思われる。

1. はじめに

常伝導加速管の電場の安定性に対する要求仕様は1度1%である。この仕様は、安定なビーム加 速をする為に、絶対値としてこの精度で決める必要があるという意味を持つ。この値の背景には、 加速電場の相対的な安定度は、更に優れているという事が仮定されている。超伝導リニアックで は、その空洞の特性を生かす為に、かなり高い加速電場を想定する(表面ピーク電場 40 MV/m)。 一般に、高電場を使う場合には、電場エラーに対する感度は増大する。従って、リングからのリ ニアックエネルギーに対する要求仕様は一定なので、SC の電場安定度に対する要求精度はきつ くなる事が予想される。リニアックの出力ビームの縦方向の性質は、デバンチャーにより最終的 に決まる。本ノートでは、デバンチャーの運転まで含めて考察して、High-β 加速管の加速電場 安定性に対する要求仕様について述べる。

加速電場のエラーについて
 加速管の構造と運転法により、ここでは以下の加速電場強度と位相のエラーを考える。

Type-A) セルエラーとタンクエラーを独立に決める。

Type-B) セルエラーをある一定の分布に保ち、タンクエラー分布を変化させる。

超伝導空洞の場合には、冷却後の電場分布の測定はなされていない。冷却とチューニングにより 電場分布は変化すると思われるので、セルエラーをゼロと仮定する事は現実的でない。DTL の場 合にも、セル電場分布を1%以内にチューニングする事は、その測定の精度の問題もあり、容易で はないとされている。

- High-β 加速管の出力ビーム
 ランダムエラーを与えた時の、出力エネルギーの偏移と加速管中の最大エネルギー偏移を示す。
 計算の方法は参考文献(1)と同じである。
- 3-1. 超伝導リニアックの場合

高電場を用いた最新の 9 セルデザインの場合の、出力ビームの様子を図1に示す(参考資料 PA01-013-R)。図中には次の三種類のエラー分布についての、計算結果が示してある。

1) 赤塗り丸 Type-A: セル電場は +- 1%, セル位相は +- 1deg, タンク電場は +-1%, タンク位相 は +- 1deg を全て独立に指定。

2) 黒中抜き丸 Type-B: セル電場は+-1%である一定の分布に固定、セル位相は+-1deg である一 定の分布に固定、タンク電場は +- 0.1%で変化、タンク位相は +- 0.1deg で変化。

3) 青ひし形 Type-B:セル電場は+-1%である一定の分布に固定、セル位相は+-1deg である一定の 分布に固定、タンク電場は +- 0.2%で変化、タンク位相は +- 0.2deg で変化。ここでセル電場分布は 2 種類を使っている。

ここで、セルエラーを与える分布は、無作為に選んでいる。その結果、図1で示すように、出力ビー ムエネルギーのデザインエネルギーからのずれは、0.1%の場合は、0.2%の場合よりも小さい結果とな っているが、エネルギー振動の最大振幅は0.1%の方が大きくなっている。図から、タンクエラーが0.1% の時の出力エネルギーの分布は+-0.5 MeV であり、タンクエラーが0.2%の時には +-0.7 MeV 程度で あるが、データ数を増やすとこれらの値は増加すると思われる。例えば、エラー0.2%の場合には+-1MeV 以上まで大きくなる事が予想される。

3-2) ACS の場合

図2にACSの場合を示す。比較の為にSCの結果も示す。次の三種類の計算結果を図示した。

- 赤抜き丸 Type-B, ACS-1:セル電場は+-1%である一定の分布に固定、セル位相は+-1deg である 一定の分布に固定、タンク電場は +- 0.2%で変化、タンク位相は+- 0.2deg で変化。ここでセ ル電場分布は2種類を使っている。
- 2) ひし形 Type-A, ACS-2:セル電場は +- 1%, セル位相は +- 1deg, タンク電場は +-0.2%, タンク位相は +-0.2deg を全て独立に指定。これは ACS-1 にて用いたセルエラー分布が、どのような分布であるか(偏っていないかどうか)を調べる目的で追加した。
- 3) 青塗り丸: Type-B, SC:セル電場は+-1%である一定の分布に固定、セル位相は+-1deg である一 定の分布に固定、タンク電場は +- 0.2%で変化、タンク位相は +- 0.2deg で変化。ここでセ ル電場分布は2種類を使っている。SC のデータは、図1に示したものと同じである。

ACS の場合、ランダムタンクエラーが 0.2 deg, 0.2%の時の出力平均エネルギーのデザインからの偏移 は、+- 0.25 MeV 程度である。



図1 SC の出力エネルギー偏移 vs. 最大エネルギー振幅。

1) 赤塗り丸 Type-A: セル電場は +-1%, セル位相は +- 1deg, タンク電場 は +-1%, タンク位相は +- 1deg を全 て独立に指定。

2)黒中抜き丸 Type-B: セル電場は
 +-1%である一定の分布に固定、セル位相は+-1degである一定の分布に固定、
 タンク電場は +- 0.1%で変化、タンク位相は +- 0.1deg で変化。

3)青ひし形 Type-B:セル電場は
 +-1%である一定の分布に固定、セル位相は+-1degである一定の分布に固定、
 タンク電場は +- 0.2%で変化、タンク位相は +- 0.2deg で変化。ここでセル電場分布は2種類を使っている。



図 2 ACS の出力エネルギー偏移 vs. 最大 エネルギー振幅。

- 赤抜き丸 Type-B, ACS-1:セル電場は +-1%である一定の分布に固定、セル位 相は+-1deg である一定の分布に固定、 タンク電場は +- 0.2%で変化、タンク 位相は +- 0.2deg で変化。ここでセル 電場分布は2種類を使っている。
- 2) ひし形 Type-A, ACS-2:セル電場は +-1%, セル位相は +- 1deg, タンク電場 は +-0.2%, タンク位相は +-0.2degを 全て独立に指定。これは ACS-1 にて用 いたセルエラー分布が、どのような分 布であるか(偏っていないかどうか) を調べる目的で追加した。
- (3) 青塗り丸: Type-B, SC:セル電場は+-1% である一定の分布に固定、セル位相は +-1deg である一定の分布に固定、タン ク電場は +- 0.2%で変化、タンク位相 は +- 0.2deg で変化。ここでセル電場 分布は 2 種類を使っている。このデー タは、図1に示したものと同じである。

3-3) 計算結果のまとめ

出力エネルギーの偏移を表1にまとめた。ここでセル位相エラーをゼロにすると、逆に出力偏移が大 きくなる場合がある事を指摘しておく。例えば、SCのタンクエラー0.2%で 688 keV の偏移の場合には、 セル位相エラーをゼロにすると 741 keV に増加する。更に、SC の場合には、ビームの過渡状態では、 予想されるエラーは、計算上(コントロール)でも大きくなる事に注意する。

	セルエラー	タンクエラー	最大出力エネル ギー偏移
SC	1%, 1deg	1%, 1deg	+3.1, -1.6 MeV
SC	1%, 1deg	0.2%, 0.2deg	+- 0.7 MeV
ACS	1%, 1deg	0.2%, 0.2deg	+- 0.25 MeV

表1 エネルギー偏移のまとめ

4. デバンチャーの動作

下流 30m の位置に 2.5MV の加速電圧を持つ 972 MHz デバンチャーを仮定する。デザインバンチの 位相をゼロとして、加速管にエラーがある場合のデバンチャーの動作を表 2 にまとめた。

表2 エラーバンチに対するデバンチャ	ァーの動作
--------------------	-------

	タンクエラー	最大出力エネル	Debuncher phase	Acceleration by
		ギー偏移		debuncher
SC	1%, 1deg	3.1 MeV	-109 deg	-2.35 MV
SC	0.2%, 0.2 deg	+0.7	-24.8	-1.05
SC	0.2%, 0.2 deg	+1.0	-35.4	-1.45
SC	0.1%, 0.1 deg	+0.5	-17.7	-0.76
ACS	0.2%, 0.2 deg	+0.25	-8.9	-0.39

この結果より、SC でタンクエラーが 0.2%, 0.2 deg であれば、デバンチャーの位相が大きくずれ てしまい、デバンチャーはうまく機能しない事がわかる。+-0.1%のエラーの時でも、要求エネル ギー半幅と同等のエネルギー偏移が、デバンチャーで起こる場合がある。SC では、実際のエラー は、これより大きくなると予想される。ACS では、タンクエラーの安定度はほとんど高周波電源 で決まり、それらは 0.1%程度と予想される(参考文献 2)。

なお、デバンチャの動作には、こまかな注文をつける可能性があり、時定数の小さい常伝導タ イプを選ぶべきである。

参考文献

1. High-β 加速管の加速について T. Kato (T. Kato の Web 参照、KEK Report 出版予定)

2. Private communication , S. Yamaguchi.